

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年10月21日(2010.10.21)

【公開番号】特開2008-160095(P2008-160095A)

【公開日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【年通号数】公開・登録公報2008-027

【出願番号】特願2007-307170(P2007-307170)

【国際特許分類】

H 0 1 L 27/28 (2006.01)

H 0 1 L 51/05 (2006.01)

H 0 1 L 27/10 (2006.01)

H 0 1 L 45/00 (2006.01)

H 0 1 L 49/00 (2006.01)

G 0 6 K 19/07 (2006.01)

G 0 6 K 19/077 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/10 4 4 9

H 0 1 L 27/10 4 6 1

H 0 1 L 27/10 4 8 1

H 0 1 L 29/28 1 0 0 B

H 0 1 L 45/00 Z

H 0 1 L 49/00 Z

G 0 6 K 19/00 H

G 0 6 K 19/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成22年9月8日(2010.9.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置の作製方法

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に剥離層を形成し、

前記剥離層上に、トランジスタと、第 1 の電極層、前記第 1 の電極層上の有機化合物を含む層、及び前記有機化合物を含む層上の第 2 の電極層を有する記憶素子と、アンテナとを有する素子層を形成し、

前記剥離層において前記基板から前記素子層を分離し、

前記第 2 の電極層として、10 atoms % 以下のスズを含むスズ及び銀の合金層を用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

基板上に剥離層を形成し、

前記剥離層上に、トランジスタと、第 1 の電極層、前記第 1 の電極層上の有機化合物を含む層、及び前記有機化合物を含む層上の第 2 の電極層を有する記憶素子と、アンテナとを有する素子層を形成し、

前記剥離層において前記基板から前記素子層を分離し、

前記第 1 の電極層または前記第 2 の電極層として、スズを含む合金層を用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、前記剥離層において前記基板から前記素子層を分離した後、可撓性を有する第 1 の基板及び可撓性を有する第 2 の基板を用いて前記素子層を封止することを特徴とする半導体装置の作製方法。